

研究简报

p型硅片表面氧化雾缺陷的吸除

张维连, 徐岳生, 刘彩池, 唐键

河北工学院材料研究中心 天津 300130

收稿日期 1992-5-3 修回日期 1992-12-2 网络版发布日期 2009-8-20 接受日期

摘要

利用快中子辐照在p型硅片中产生辐照缺陷, 利用其作为热处理时硅中氧沉淀的成核中心, 在硅片表面层形成洁净区和在体内形成吸杂区, 能有效地抑制硅片表面氧化雾缺陷的形成. 提出了较为实用的退火工艺和简单的解释.

关键词 [硅片](#) [雾缺陷](#) [快中子辐照](#)

分类号

GETTING OF THE HAZE DEFECTS ON p-Si WAFER

Zhang Weilian, Xu Yuesheng, Liu Caichi, Tang Jian

Hebei Institute of Technology, Tianjin 300130

Abstract

The irradiation defects in Si wafer introduced by fast neutron can be used to act as nuclei of oxygen precipitation. These defeccts accelerate the formarion of oxygen precipitation in denuded region as well as getting irapurity region, thus haze dtfects on Si wafer can be restraint effectively. In this paper, a more practicacle annealing technology and a brief interpretation are given.

Key words [Si wafer](#) [Haze defect](#) [Fast neutron irradiation](#)

DOI:

通讯作者

作者个人主页 张维连; 徐岳生; 刘彩池; 唐键

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(874KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [复制索引](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“硅片”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [张维连](#)

· [徐岳生](#)

· [刘彩池](#)

· [唐键](#)